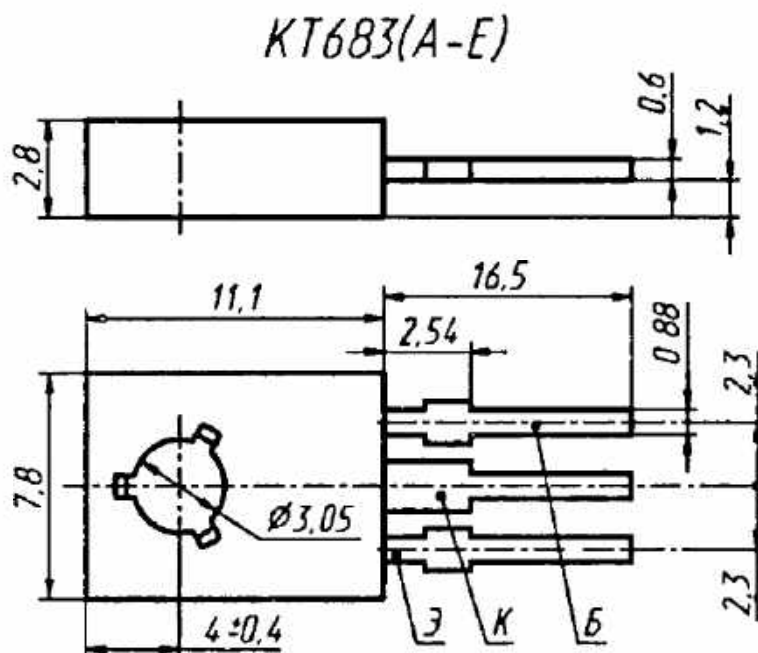


КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 0,15$ А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г	40...120
КТ683Б, КТ683Д	80...240
КТ683Е	160...480

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_3 = 50$ мА,
не менее

50 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 30$ мА,
не менее:

КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более

0,45 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более

1 В

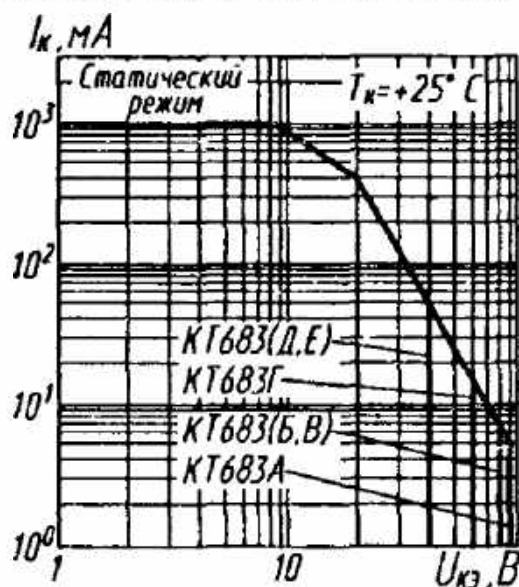
Пробивное напряжение коллектор—эмиттер при $I_k = 0,1$ мА, $R_{БЭ} = 3$ кОм, не менее:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
Пробивное напряжение база—эмиттер при $I_3 = 0,1$ мА, не менее:	
КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В
Время включения при $U_{кз} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение	0,1* мкс
Время выключения при $U_{кз} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение	0,2* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кБ} = 10$ В, не более	
	15* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{зБ} = 0,5$ В, не более	
	65* пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кБ} = 90$ В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более	
	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

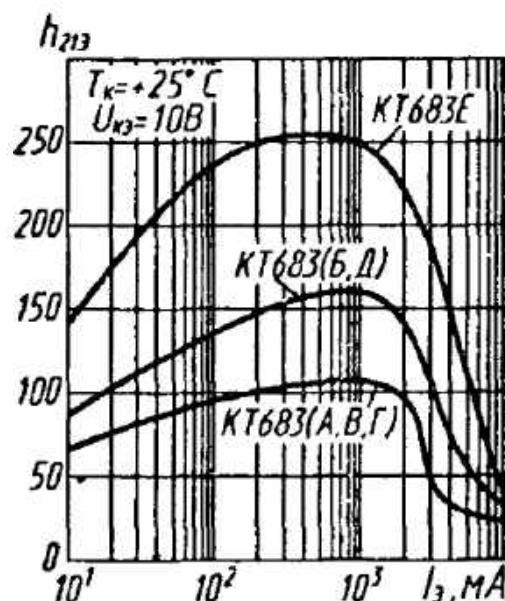
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер: при $R_{БЭ} = 3$ кОм:	
КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В
при $R_{БЭ} = \infty$:	
КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В
Постоянное напряжение база—эмиттер:	
КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В

Постоянный ток коллектора	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 1$ мс	2 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_K = -60...+25$ °C:	
с теплоотводом	8 Вт
без теплоотвода	1,2 Вт
Температура р-п перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +125 °C

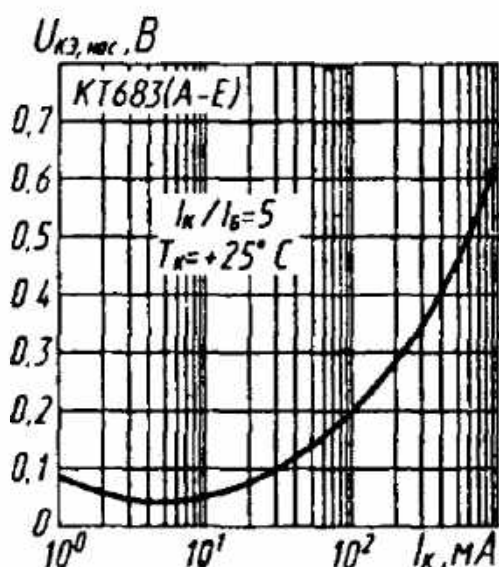
¹ При $T_K \geq 25$ °C $P_{K, \text{макс}}$ снижается линейно на 0,064 Вт/°C с теплоотводом и на 0,0096 Вт/°C без теплоотвода.



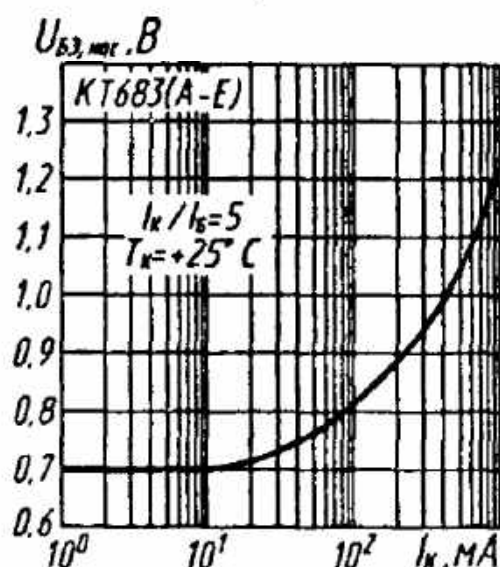
Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора